

オペアンプ・コンパレータ シリーズ

入出力フルスイング

高電圧動作 CMOS オペアンプ

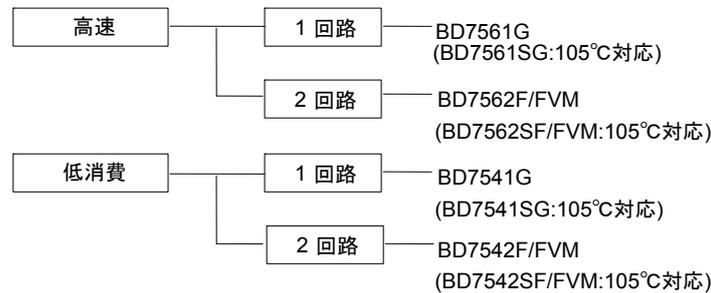


**BD7561G, BD7561SG, BD7541G, BD7541SG,
BD7562F/FVM, BD7562S F/FVM, BD7542F/FVM, BD7542S F/FVM**

No.09049JAT05

●概要

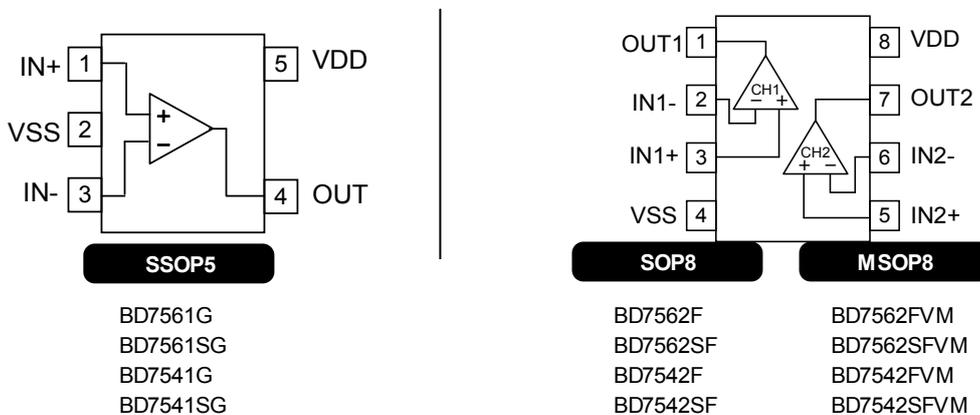
CMOS オペアンプ BD7561/BD7541 ファミリと BD7562/BD7542 ファミリは、位相補償容量内蔵の入出力フルスイングのオペアンプ 1 回路/2 回路を 1 チップに集積したモノリシック IC です。特に動作範囲が +5[V]~+14.5[V](単一電源動作の場合)と高電圧で、消費電流が少なく、入力バイアス電流が非常に小さいことが特徴です。



●特長

- 1) 高電圧 (+5[V]~+14.5[V])
- 2) +5[V]~+14.5[V](単電源)
±2.5[V]~±7.25[V](両電源)
- 3) 入力、出力ともに、フルスイング動作可能
- 4) 位相補償容量内蔵
- 5) 高速動作可能(BD7561 ファミリ, BD7562 ファミリ)
- 6) 消費電流が少ない(BD7541 ファミリ, BD7542 ファミリ)
- 7) 直流電圧利得が大きい
- 8) 静電気保護回路内蔵
人体モデル(HBM) ±4000[V](Typ.)
- 9) 温度範囲が広い
-40[°C]~+85[°C] (BD7561G, BD7562 ファミリ, BD7541G, BD7542 ファミリ)
-40[°C]~+105[°C] (BD7561SG, BD7562S ファミリ, BD7541SG, BD7542S ファミリ)

●ピン配置



●絶対最大定格 (Ta=25[°C])

項目	記号	定格		単位
		BD7561G, BD7562 F/FVM BD7541G, BD7542 F/FVM	BD7561SG, BD7562S F/FVM BD7541SG, BD7542S F/FVM	
電源電圧	VDD-VSS	+15.5		V
差動入力電圧 ^(*1)	Vid	VDD-VSS		V
同相入力電圧	Vicm	(VSS-0.3)~(VDD+0.3)		V
動作温度範囲	Topr	-40~+85	-40~+105	°C
保存温度範囲	Tstg	-55~+125		°C
接合部温度	Tjmax	+125		°C

(注) 絶対最大定格とは、端子にこの範囲の電圧を印加しても破壊しない限界を示す値であり、動作を保証するものではありません。
電源の逆接続は破壊の恐れがあるのでご注意ください。

(*1) 差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位はVSS以上の電位としてください。

●電気的特性

OBD7561 ファミリ (特に指定のない限り VDD=+12[V], VSS=0[V], Ta=25[°C])

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			BD7561G, BD7561SG	最小	標準		
入力オフセット電圧 ^{(*2)(*4)}	Vio	25°C	-	1	9	mV	VDD=5~14.5[V], VOUT=VDD/2
		全温度範囲	-	-	10		
入力オフセット電流 ^(*2)	Iio	25°C	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流 ^(*2)	Ib	25°C	-	1	-	pA	-
回路電流 ^(*4)	IDD	25°C	-	370	550	μA	RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=5[V], VIN=2.5[V] RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=12[V], VIN=6.0[V]
		全温度範囲	-	-	600		
		25°C	-	440	650		
		全温度範囲	-	-	700		
High レベル出力電圧	VOH	25°C	VDD-0.1	-	-	V	RL=10[kΩ]
Low レベル出力電圧	VOL	25°C	-	-	VSS+0.1	V	RL=10[kΩ]
大振幅電圧利得	AV	25°C	70	95	-	dB	RL=10[kΩ]
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	12	V	VDD-VSS=12[V]
同相信号除去比	CMRR	25°C	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	60	80	-	dB	-
出力ソース電流 ^(*3)	IOH	25°C	3	8	-	mA	VDD-0.4[V]
出力シンク電流 ^(*3)	IOL	25°C	4	14	-	mA	VSS+0.4[V]
スルーレート	SR	25°C	-	0.9	-	V/μs	CL=25[pF]
利得帯域幅積	FT	25°C	-	1.0	-	MHz	CL=25[pF], AV=40[dB]
位相余裕	θ	25°C	-	50°	-	-	CL=25[pF], AV=40[dB]
全高調波歪率	THD	25°C	-	0.05	-	%	VOUT=1[Vp-p], f=1[kHz]

(*2) 絶対値表記

(*3) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

(*4) 全温度範囲 BD7561, BD7562 : Ta=-40[°C]~+85[°C] BD7561S, BD7562S : Ta=-40[°C]~+105[°C]

OBD7562 ファミリ (特に指定のない限り VDD=+12[V], VSS=0[V], Ta=25[°C])

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			BD7562 F/FVM BD7562S F/FVM				
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ⁽²⁾⁽⁴⁾	Vio	25°C	-	1	9	mV	VDD=5~14.5[V], VOUT=VDD/2
		全温度範囲	-	-	10		
入力オフセット電流 ⁽²⁾	Iio	25°C	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流 ⁽²⁾	Ib	25°C	-	1	-	pA	-
回路電流 ⁽⁴⁾	IDD	25°C	-	750	1300	μA	RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=5[V], VIN=2.5[V] RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=12[V], VIN=6.0[V]
		全温度範囲	-	-	1500		
		25°C	-	900	1400		
		全温度範囲	-	-	1600		
High レベル出力電圧	VOH	25°C	VDD-0.1	-	-	V	RL=10[kΩ]
Low レベル出力電圧	VOL	25°C	-	-	VSS+0.1	V	RL=10[kΩ]
大振幅電圧利得	AV	25°C	70	95	-	dB	RL=10[kΩ]
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	3	V	VDD-VSS=12[V]
同相信号除去比	CMRR	25°C	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	60	80	-	dB	-
出力ソース電流 ⁽³⁾	IOH	25°C	3	8	-	mA	VDD-0.4[V]
出力シンク電流 ⁽³⁾	IOL	25°C	4	14	-	mA	VSS+0.4[V]
スルーレート	SR	25°C	-	0.9	-	V/μs	CL=25[pF]
利得帯域幅積	FT	25°C	-	1.0	-	MHz	CL=25[pF], AV=40[dB]
位相余裕	θ	25°C	-	50°	-	-	CL=25[pF], AV=40[dB]
全高調波歪率	THD	25°C	-	0.05	-	%	VOUT=1[Vp-p], f=1[kHz]

(2) 絶対値表記

(3) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

(4) 全温度範囲 BD7561, BD7562 : Ta=-40[°C]~+85[°C] BD7561S, BD7562S : Ta=-40[°C]~+105[°C]

OBD7541 ファミリ (特に指定のない限り VDD=+12[V], VSS=0[V], Ta=25[°C])

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			BD7541G, BD7541SG				
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ⁽⁵⁾⁽⁷⁾	Vio	25°C	-	1	9	mV	VDD=5~14.5[V], VOUT=VDD/2
		全温度範囲	-	-	10		
入力オフセット電流 ⁽⁵⁾	Iio	25°C	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流 ⁽⁵⁾	Ib	25°C	-	1	-	pA	-
回路電流 ⁽⁷⁾	IDD	25°C	-	170	300	μA	RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=5[V], VIN=2.5[V] RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=12[V], VIN=6.0[V]
		全温度範囲	-	-	400		
		25°C	-	180	320		
		全温度範囲	-	-	420		
High レベル出力電圧	VOH	25°C	VDD-0.1	-	-	V	RL=10[kΩ]
Low レベル出力電圧	VOL	25°C	-	-	VSS+0.1	V	RL=10[kΩ]
大振幅電圧利得	AV	25°C	70	95	-	dB	RL=10[kΩ]
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	12	V	VDD-VSS=12[V]
同相信号除去比	CMRR	25°C	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	60	80	-	dB	-
出力ソース電流 ⁽⁶⁾	IOH	25°C	2	4	-	mA	VDD-0.4[V]
出力シンク電流 ⁽⁶⁾	IOL	25°C	3	7	-	mA	VSS+0.4[V]
スルーレート	SR	25°C	-	0.3	-	V/μs	CL=25[pF]
利得帯域幅積	FT	25°C	-	0.6	-	MHz	CL=25[pF], AV=40[dB]
位相余裕	θ	25°C	-	50°	-	-	CL=25[pF], AV=40[dB]
全高調波歪率	THD	25°C	-	0.05	-	%	VOUT=1[Vp-p], f=1[kHz]

(5) 絶対値表記

(6) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

(7) 全温度範囲 BD7541, BD7542 : Ta=-40[°C]~+85[°C] BD7541S, BD7542S : Ta=-40[°C]~+105[°C]

OBD7541 ファミリ, BD7542 ファミリ (特に指定のない限り VDD=+12[V], VSS=0[V], Ta=25[°C])

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			BD7542 F/FVM BD7542S F/FVM				
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ^(*) (*)	Vio	25°C	-	1	9	mV	VDD=5~14.5[V], VOUT=VDD/2
		全温度範囲	-	-	10		
入力オフセット電流 ^(*)	Iio	25°C	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流 ^(*)	Ib	25°C	-	1	-	pA	-
回路電流 ^(*)	IDD	25°C	-	340	650	μA	RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=5[V], VIN=2.5[V] RL=∞ All Op-Amps AV=0[dB], VDD=12[V], VIN=6.0[V]
		全温度範囲	-	-	850		
		25°C	-	400	780		
		全温度範囲	-	-	900		
High レベル出力電圧	VOH	25°C	VDD-0.1	-	-	V	RL=10[kΩ]
Low レベル出力電圧	VOL	25°C	-	-	VSS+0.1	V	RL=10[kΩ]
大振幅電圧利得	AV	25°C	70	95	-	dB	RL=10[kΩ]
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	3	V	VDD-VSS=12[V]
同相信号除去比	CMRR	25°C	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	60	80	-	dB	-
出力ソース電流 ^(*)	IOH	25°C	2	4	-	mA	VDD-0.4[V]
出力シンク電流 ^(*)	IOL	25°C	3	7	-	mA	VSS+0.4[V]
スルーレート	SR	25°C	-	0.3	-	V/μs	CL=25[pF]
利得帯域幅積	FT	25°C	-	0.6	-	MHz	CL=25[pF], AV=40[dB]
位相余裕	θ	25°C	-	50°	-	-	CL=25[pF], AV=40[dB]
全高調波歪率	THD	25°C	-	0.05	-	%	VOUT=1[Vp-p], f=1[kHz]

(*) 絶対値表記

(*) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

(*) 出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

(*) 全温度範囲 BD7541, BD7542 : Ta=-40[°C]~+85[°C] BD7541S, BD7542S : Ta=-40[°C]~+105[°C]

●参考データ BD7561 ファミリ

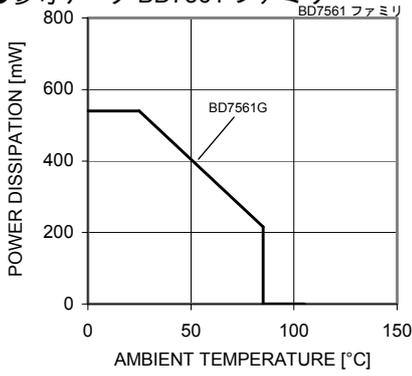


Fig. 1
ディレーティングカーブ

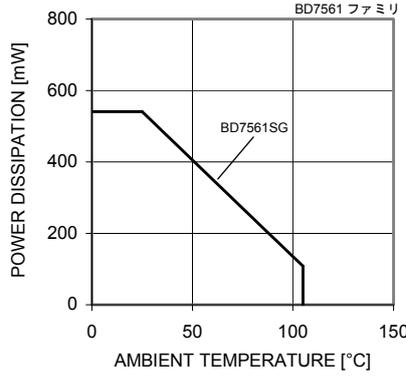


Fig. 2
ディレーティングカーブ

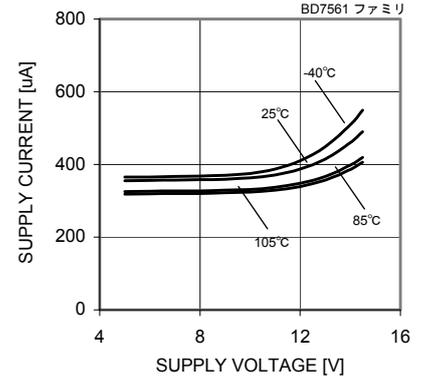


Fig. 3
回路電流－電源電圧特性

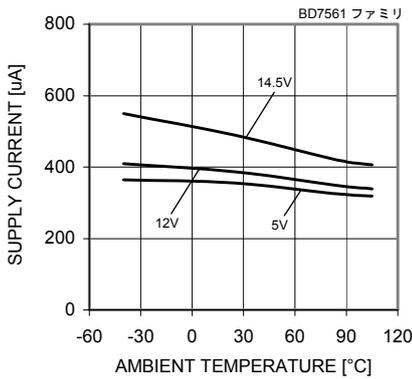


Fig. 4
回路電流－温度特性

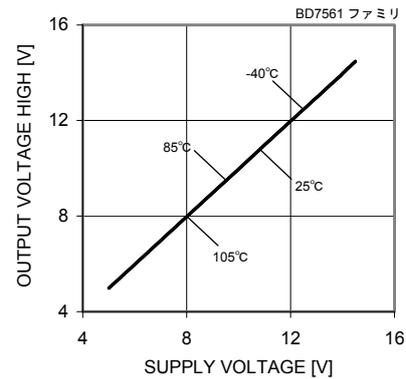


Fig. 5
High レベル出力電圧－電源電圧特性
(RL=10[kΩ])

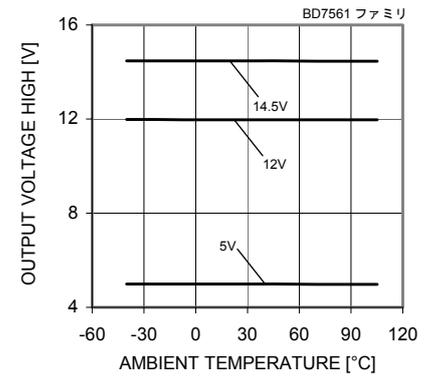


Fig. 6
High レベル出力電圧－温度特性
(RL=10[kΩ])

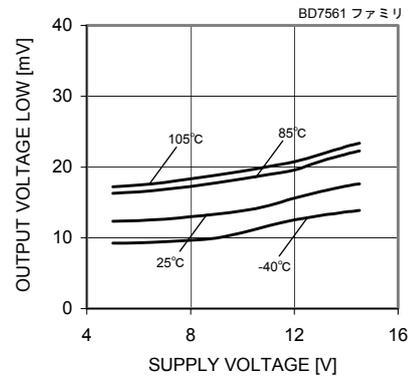


Fig. 7
Low レベル出力電圧－電源電圧特性
(RL=10[kΩ])

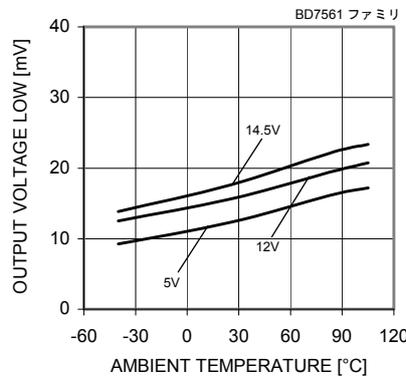


Fig. 8
Low レベル出力電圧－温度特性
(RL=10[kΩ])

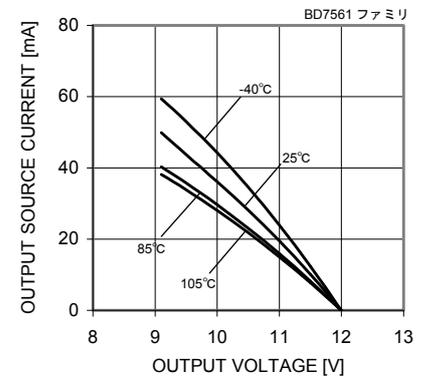


Fig. 9
出力ソース電流－出力電圧特性
(VDD=12[V])

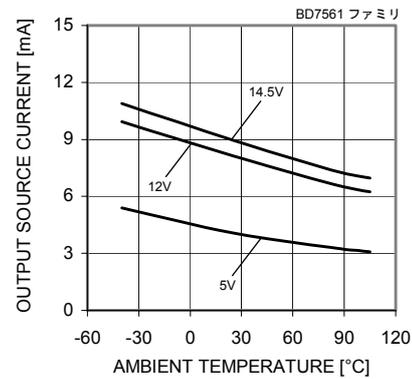


Fig. 10
出力ソース電流－温度特性
(VOUT=VDD-0.4[V])

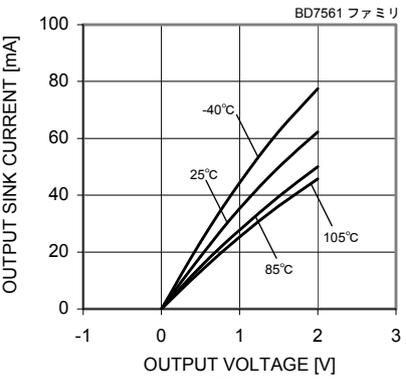


Fig. 11
出力シンク電流－出力電圧特性
(VDD=12[V])

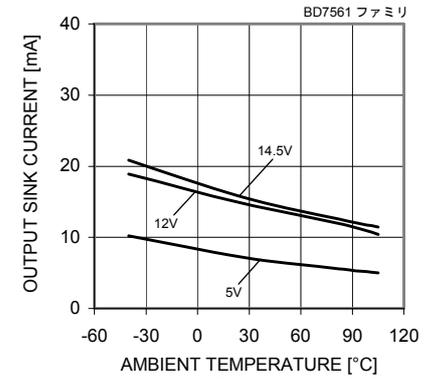


Fig. 12
出力シンク電流－温度特性
(VOUT=VDD-11.6[V])

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7561 : -40[°C]~+85[°C] BD7561S : -40[°C]~+105[°C]

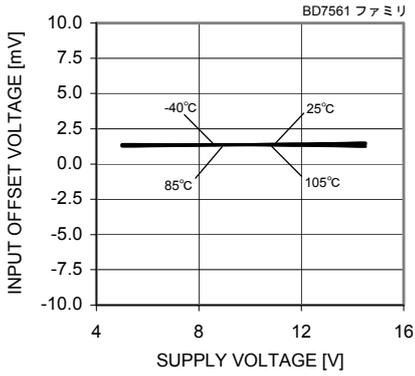


Fig. 13

入力オフセット電圧—電源電圧特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

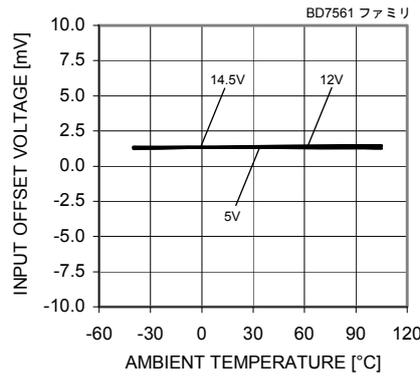


Fig. 14

入力オフセット電圧—温度特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

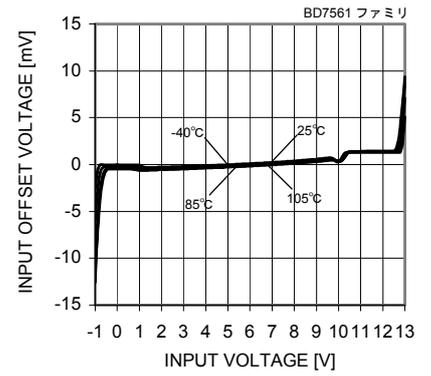


Fig. 15

同相入力電圧範囲
($V_{DD}=12[V]$)

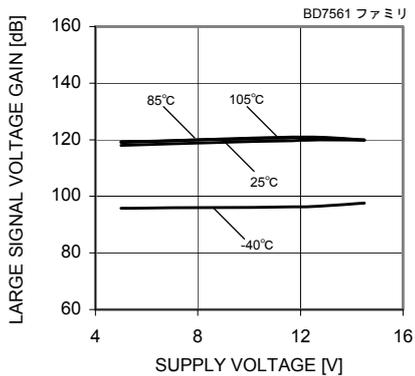


Fig. 16

大振幅電圧利得—電源電圧特性

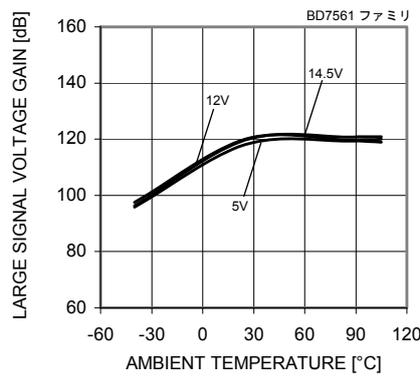


Fig. 17

大振幅電圧利得—温度特性

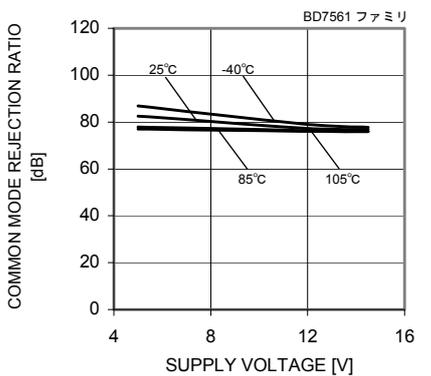


Fig. 18

同相信号除去比—電源電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

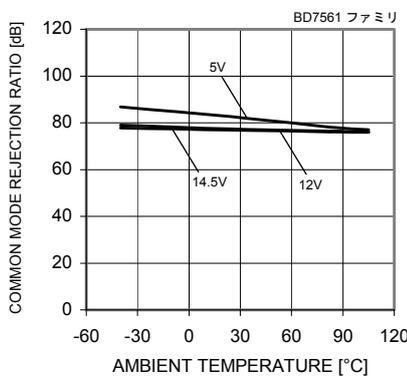


Fig. 19

同相信号除去比—温度特性
($V_{DD}=12[V]$)

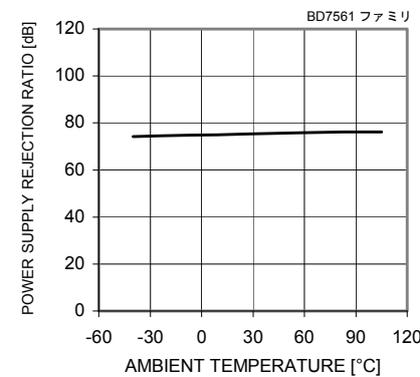


Fig. 20

電源電圧除去比—温度特性

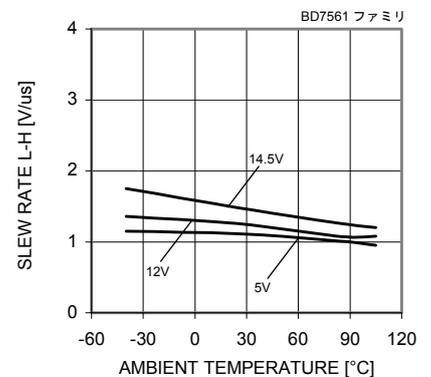


Fig. 21

スルーレート(L-H)—温度特性

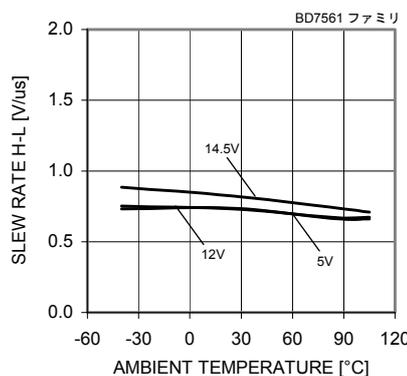


Fig. 22

スルーレート(H-L)—温度特性

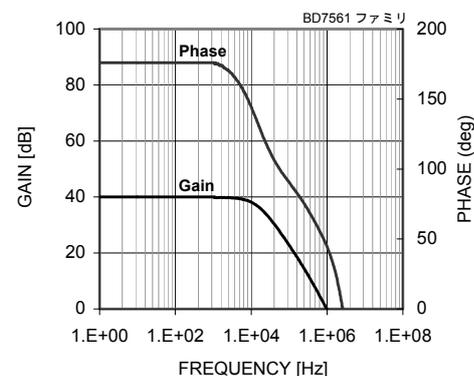


Fig. 23

電圧利得—周波数特性

(*) 上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7561: -40[°C]~+85[°C] BD7561S: -40[°C]~+105[°C]

●参考データ BD7562 ファミリ

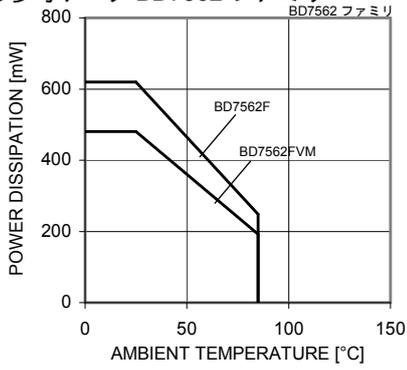


Fig. 24

ディレーティングカーブ

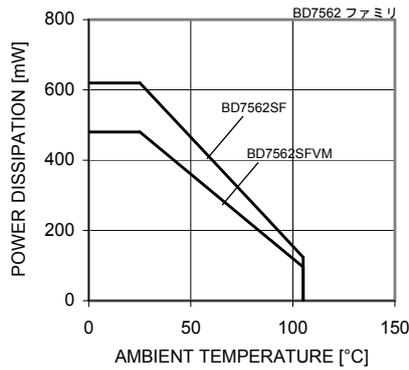


Fig. 25

ディレーティングカーブ

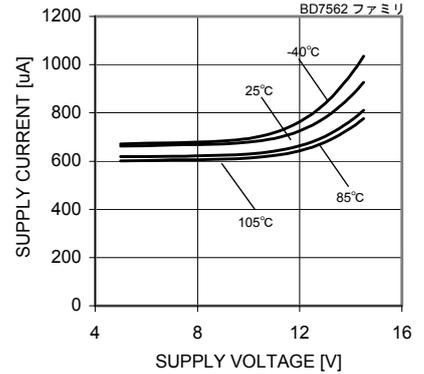


Fig. 26

回路電流－電源電圧特性

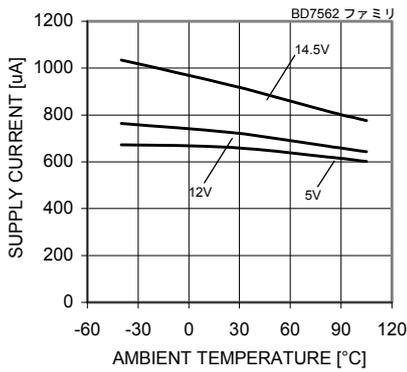


Fig. 27

回路電流－温度特性

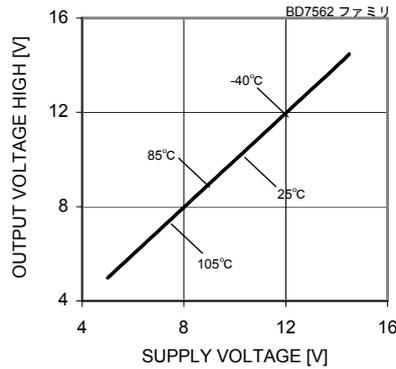


Fig. 28

High レベル出力電圧－電源電圧特性
($R_L=10[k\Omega]$)

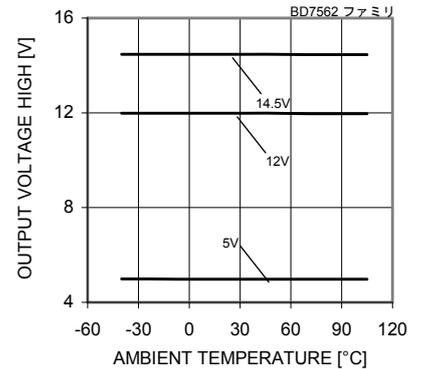


Fig. 29

High レベル出力電圧－温度特性
($R_L=10[k\Omega]$)

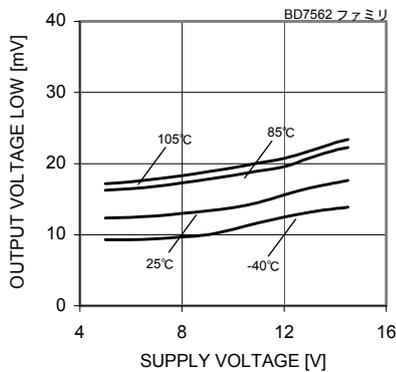


Fig. 30

Low レベル出力電圧－電源電圧特性
($R_L=10[k\Omega]$)

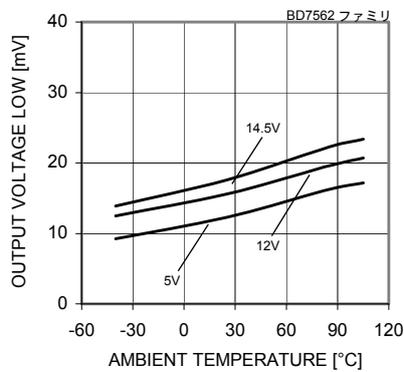


Fig. 31

Low レベル出力電圧－温度特性
($R_L=10[k\Omega]$)

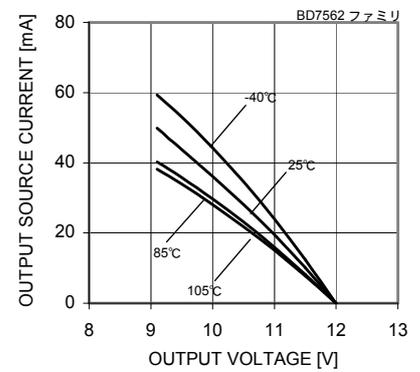


Fig. 32

出カソース電流－出力電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

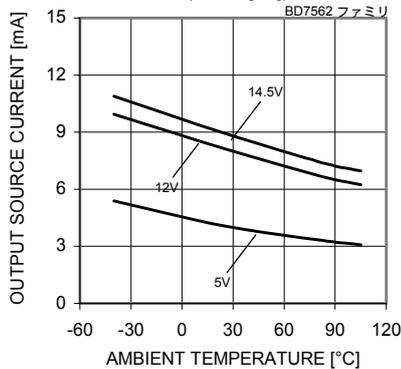


Fig. 33

出カソース電流－温度特性
($V_{OUT}=V_{DD}-0.4[V]$)

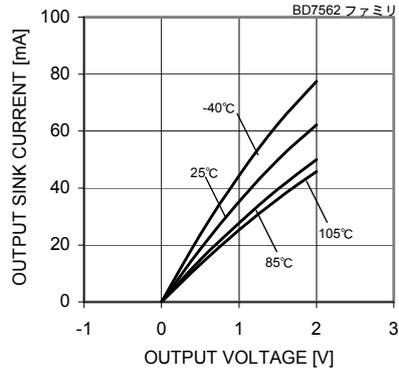


Fig. 34

出カシンク電流－出力電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

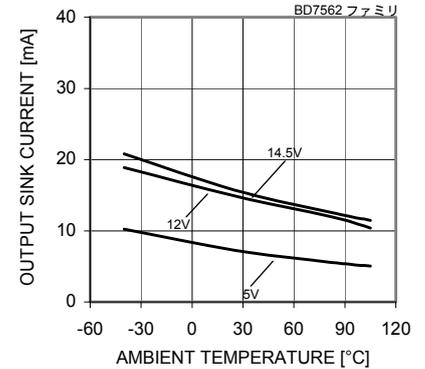


Fig. 35

出カシンク電流－温度特性
($V_{OUT}=V_{DD}-11.6[V]$)

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7562 : -40[°C]~+85[°C] BD7562S : -40[°C]~+105[°C]

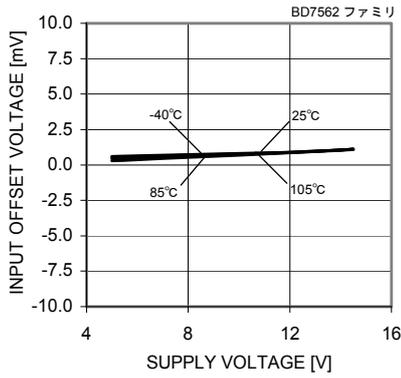


Fig. 36
入力オフセット電圧—電源電圧特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

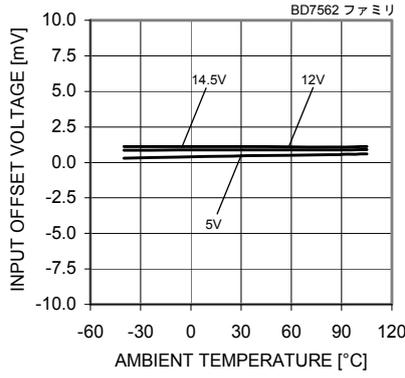


Fig. 37
入力オフセット電圧—温度特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

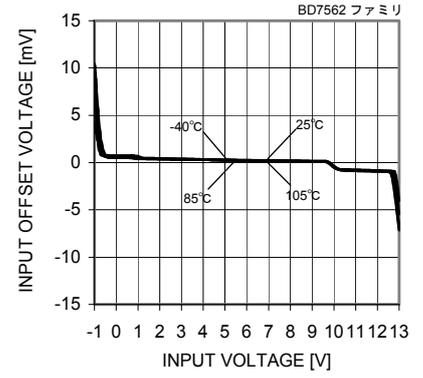


Fig. 38
同相入力電圧範囲
($V_{DD}=12[V]$)

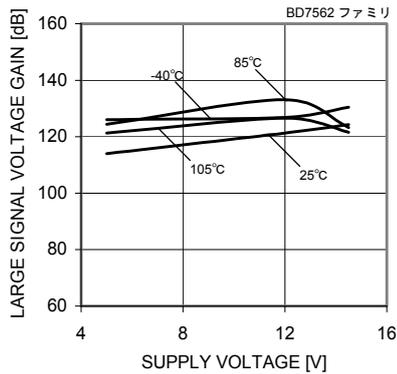


Fig. 39
大振幅電圧利得—電源電圧特性

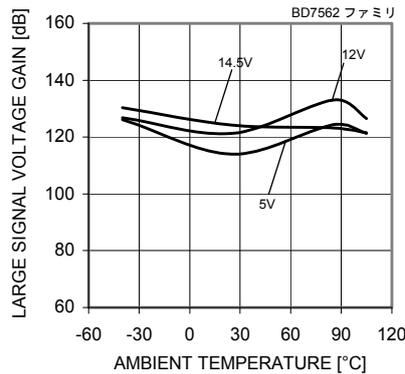


Fig. 40
大振幅電圧利得—温度特性

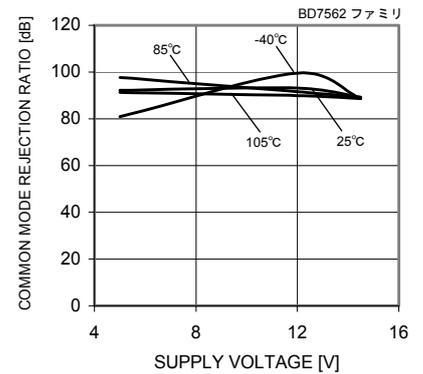


Fig. 41
同相信号除去比—電源電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

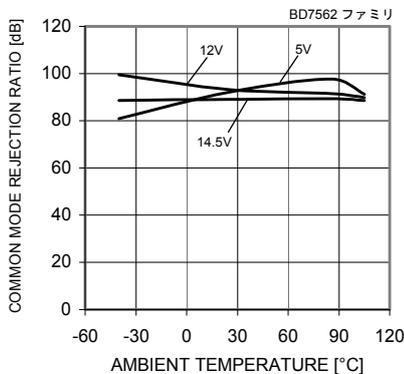


Fig. 42
同相信号除去比—温度特性
($V_{DD}=12[V]$)

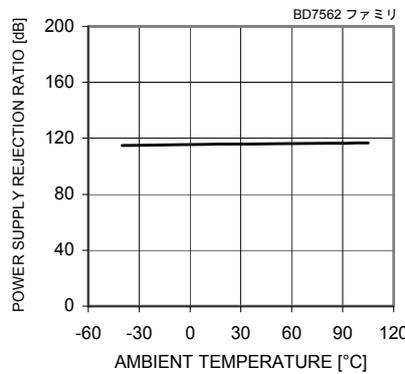


Fig. 43
電源電圧除去比—温度特性

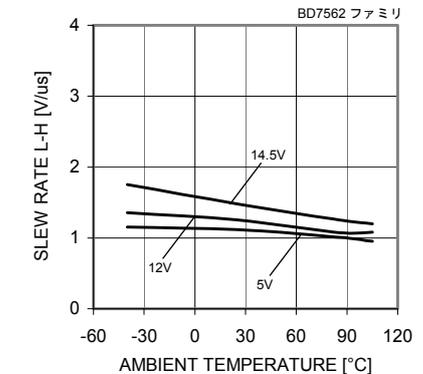


Fig. 44
スルーレート(L-H)—温度特性

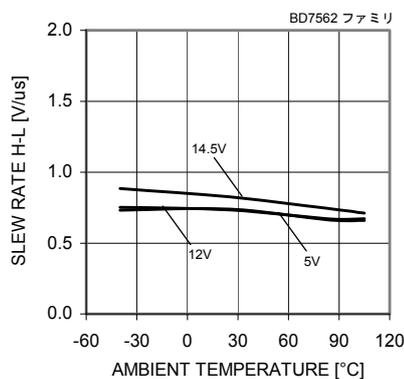


Fig. 45
スルーレート(H-L)—温度特性

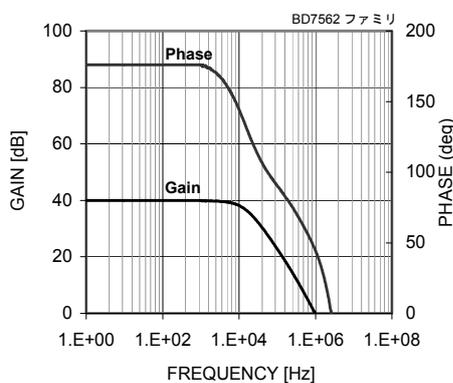


Fig. 46
電圧利得—周波数特性

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7562 : -40[°C]~+85[°C] BD7562S : -40[°C]~+105[°C]

●参考データ BD7541 ファミリ

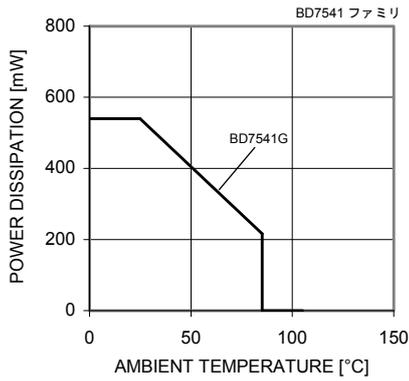


Fig. 47
ディレーティングカーブ

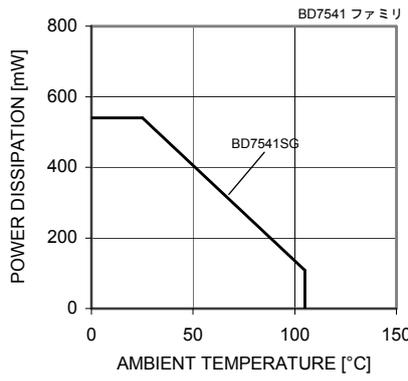


Fig. 48
ディレーティングカーブ

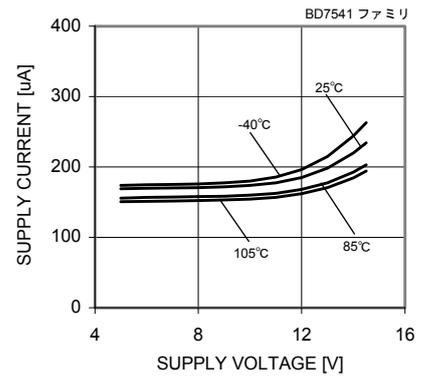


Fig. 49
回路電流－電源電圧特性

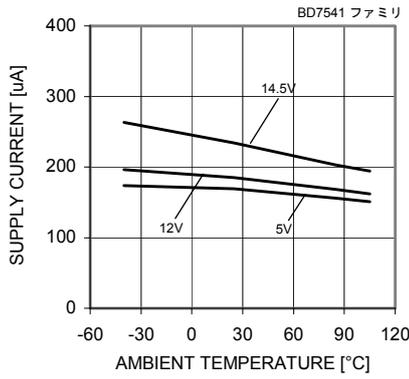


Fig. 50
回路電流－温度特性

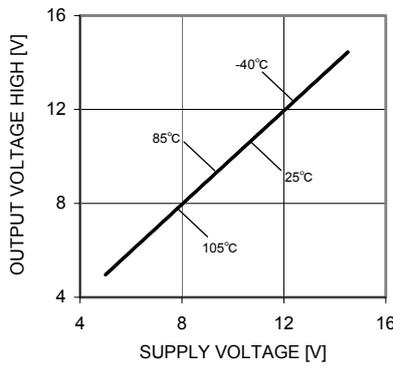


Fig. 51
High レベル出力電圧－電源電圧特性
($R_L=10[k\Omega]$)

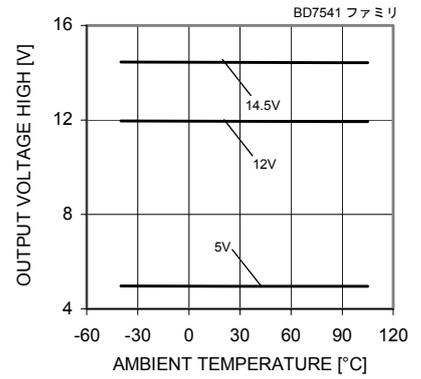


Fig. 52
High レベル出力電圧－温度特性
($R_L=10[k\Omega]$)

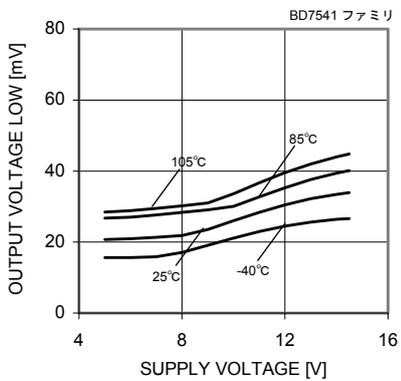


Fig. 53
Low レベル出力電圧－電源電圧特性
($R_L=10[k\Omega]$)

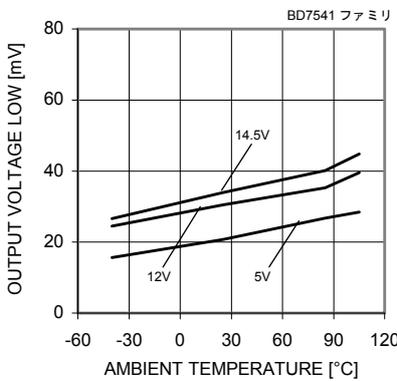


Fig. 54
Low レベル出力電圧－温度特性
($R_L=10[k\Omega]$)

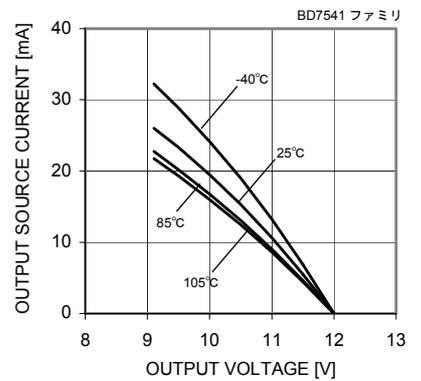


Fig. 55
出力ソース電流－出力電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

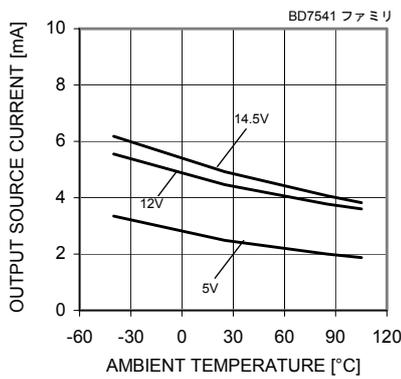


Fig. 56
出力ソース電流－温度特性
($V_{OUT}=V_{DD}-0.4[V]$)

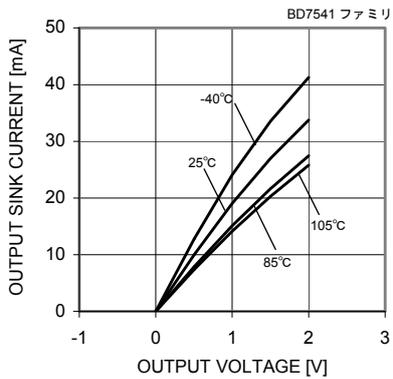


Fig. 57
出力シンク電流－出力電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

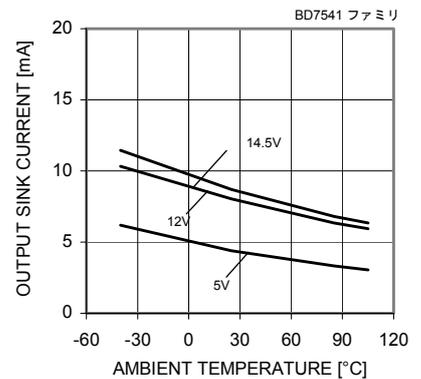


Fig. 58
出力シンク電流－温度特性
($V_{OUT}=V_{DD}-11.6[V]$)

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7541 : -40[°C]~+85[°C] BD7541S : -40[°C]~+105[°C]

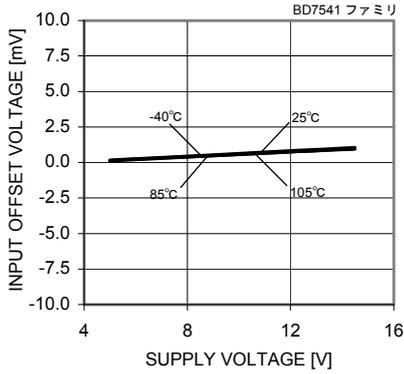


Fig. 59

入力オフセット電圧—電源電圧特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

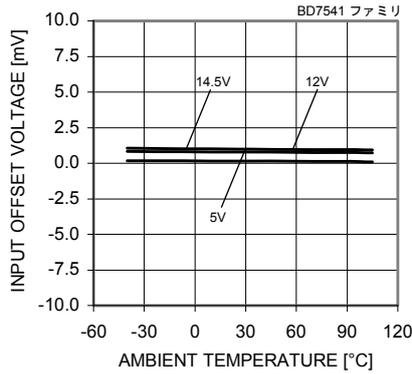


Fig. 60

入力オフセット電圧—温度特性
($V_{icm}=V_{DD}$, $V_{OUT}=V_{DD}/2$)

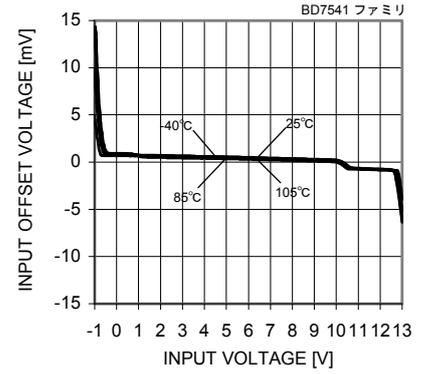


Fig. 61

同相入力電圧範囲
($V_{DD}=12[V]$)

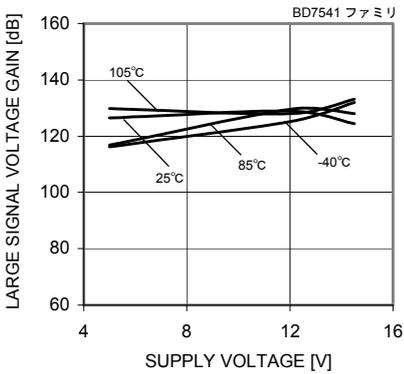


Fig. 62

大振幅電圧利得—電源電圧特性

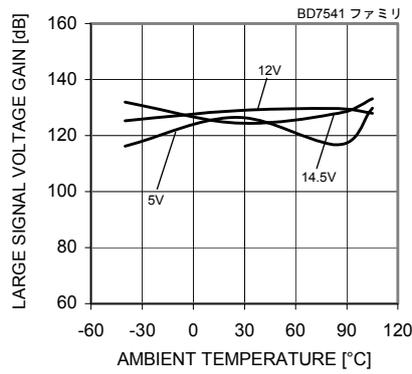


Fig. 63

大振幅電圧利得—温度特性

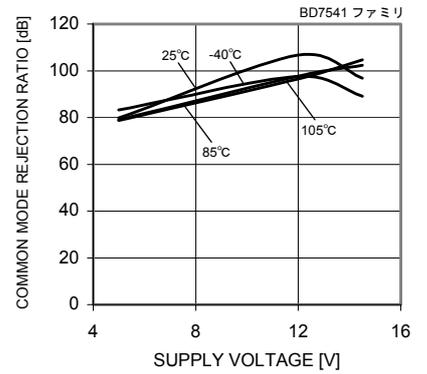


Fig. 64

同相信号除去比—電源電圧特性
($V_{DD}=12[V]$)

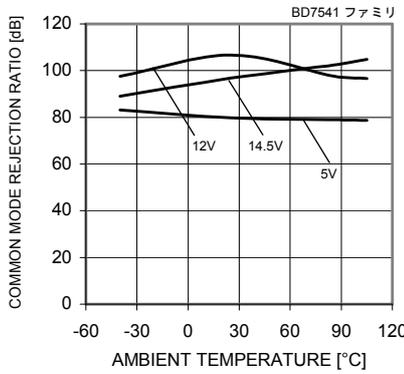


Fig. 65

同相信号除去比—温度特性
($V_{DD}=12[V]$)

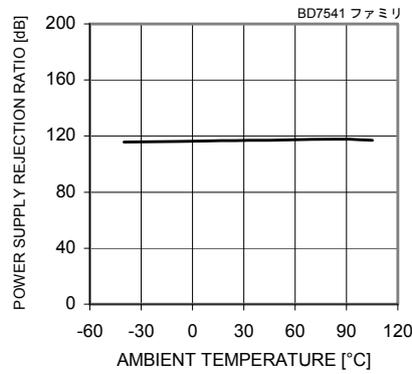


Fig. 66

電源電圧除去比—温度特性

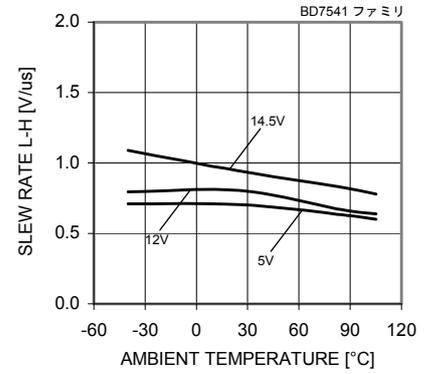


Fig. 67

スルーレート(L-H)—温度特性

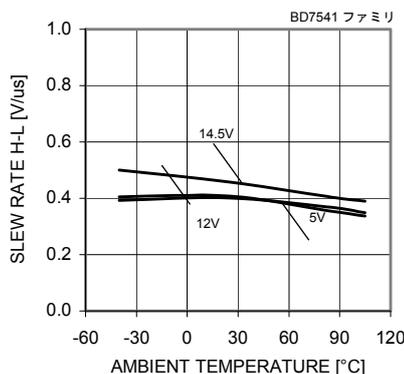


Fig. 68

スルーレート(H-L)—温度特性

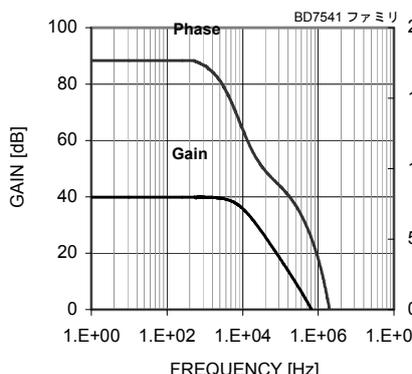


Fig. 69

電圧利得—周波数特性

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7541 : -40°C~+85°C BD7541S : -40°C~+105°C

●参考データ BD7542 ファミリ

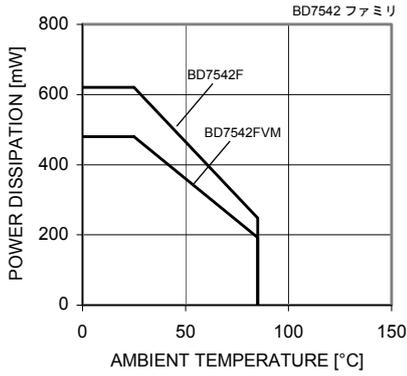


Fig. 70
ディレーティングカーブ

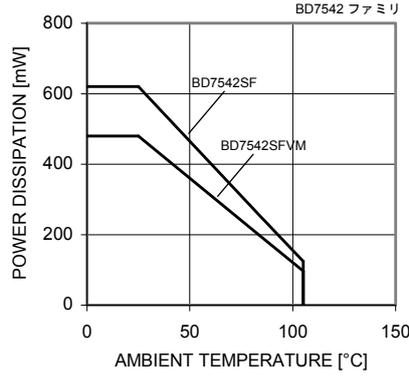


Fig. 71
ディレーティングカーブ

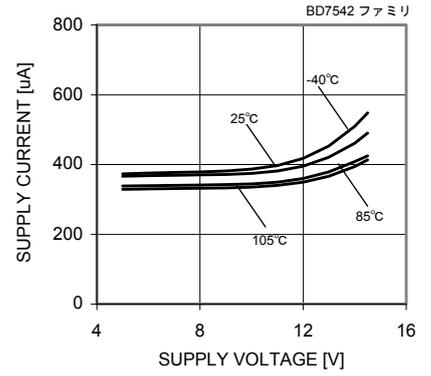


Fig. 72
回路電流-電源電圧特性

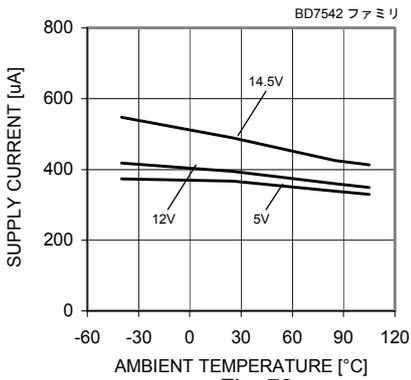


Fig. 73
回路電流-温度特性

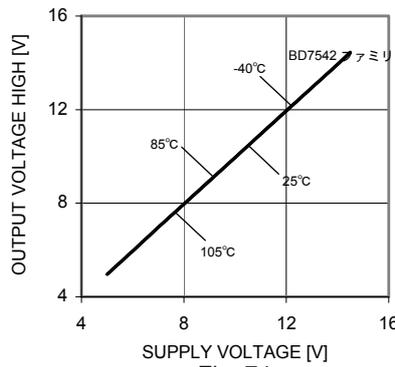


Fig. 74
High レベル出力電圧-電源電圧特性
(RL=10[kΩ])

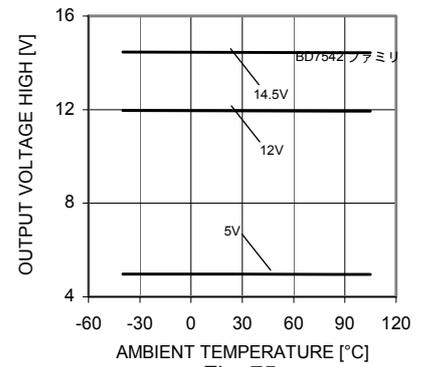


Fig. 75
High レベル出力電圧-温度特性
(RL=10[kΩ])

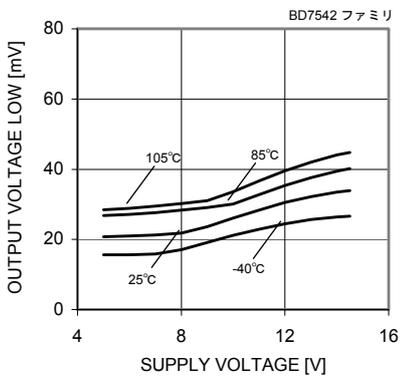


Fig. 76
Low レベル出力電圧-電源電圧特性
(RL=10[kΩ])

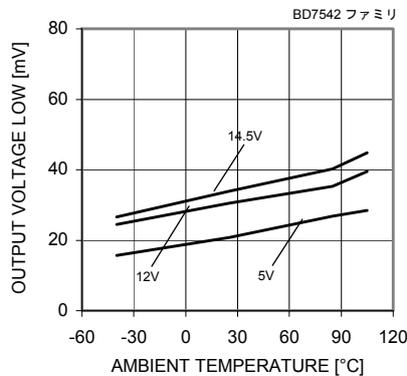


Fig. 77
Low レベル出力電圧-温度特性
(RL=10[kΩ])

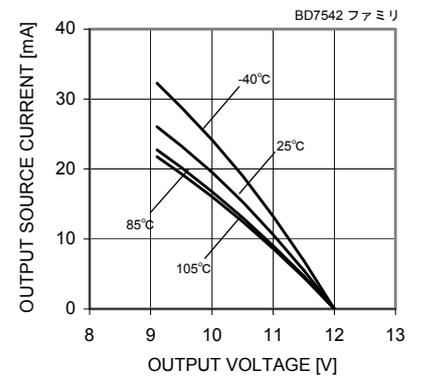


Fig. 78
出力ソース電流-出力電圧特性
(VDD=12[V])

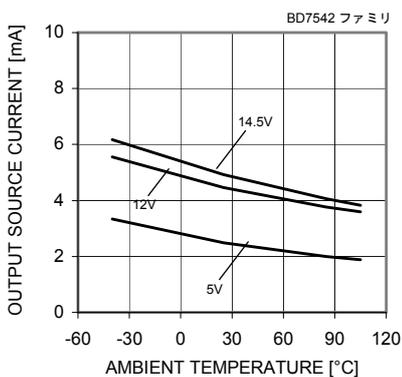


Fig. 79
出力ソース電流-温度特性
(VOUT=VDD-0.4[V])

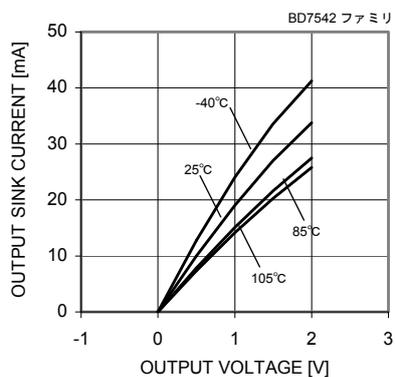


Fig. 80
出力シンク電流-出力電圧特性
(VDD=12[V])

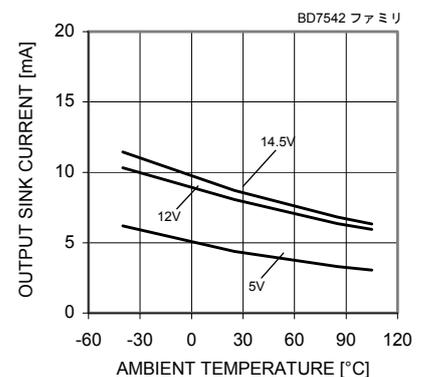


Fig. 81
出力シンク電流-温度特性
(VOUT=VDD-11.6[V])

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7561: -40[°C]~+85[°C] BD7561S: -40[°C]~+105[°C]

●参考データ BD7542 ファミリ

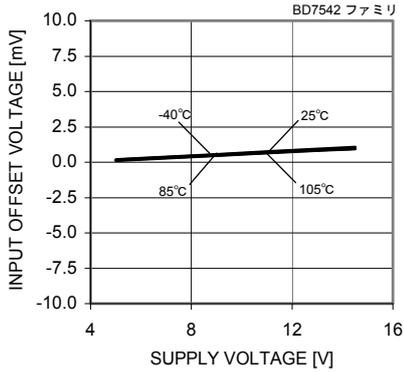


Fig. 82

入力オフセット電圧—電源電圧特性
(Vicm=VDD, VOUT=VDD/2)

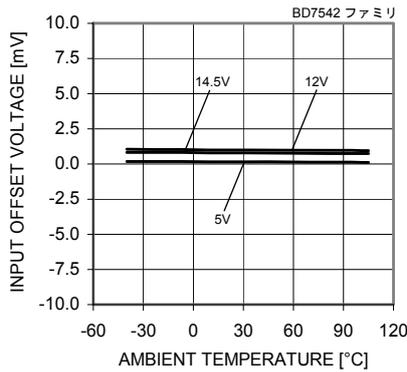


Fig. 83

入力オフセット電圧—温度特性
(Vicm=VDD, VOUT=VDD/2)

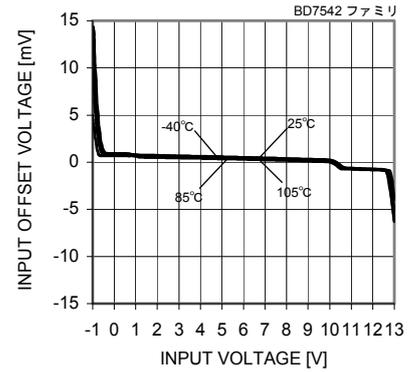


Fig. 84

同相入力電圧範囲
(VDD=12[V])

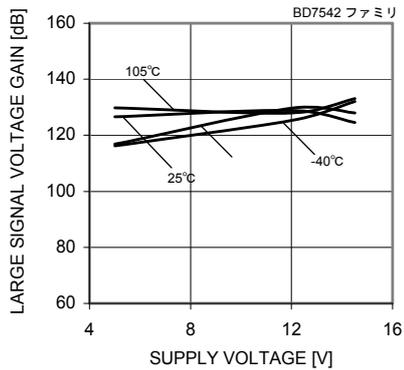


Fig. 85

大振幅電圧利得—電源電圧特性

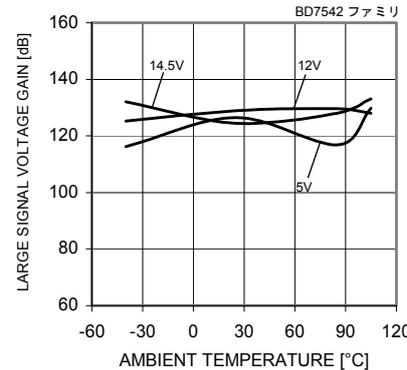


Fig. 86

大振幅電圧利得—温度特性

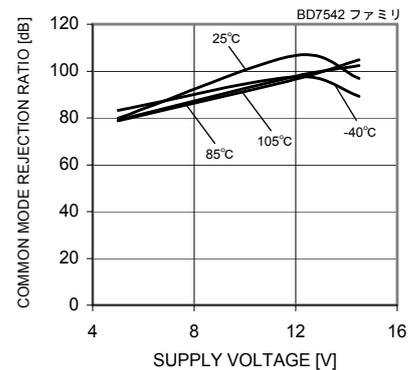


Fig. 87

同相信号除去比—電源電圧特性
(VDD=12[V])

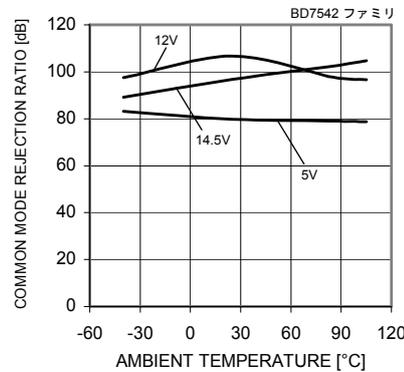


Fig. 88

同相信号除去比—温度特性
(VDD=12[V])

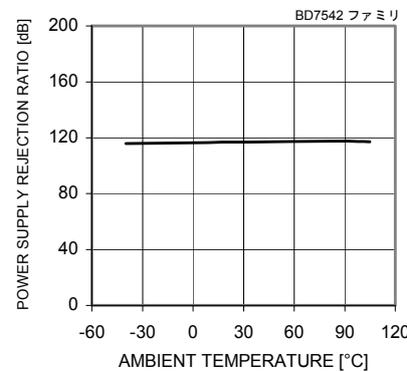


Fig. 89

電源電圧除去比—温度特性

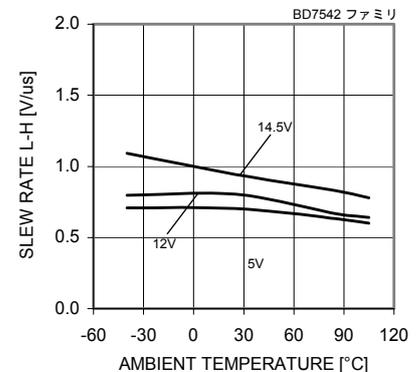


Fig. 90

スルーレート(L-H)—温度特性

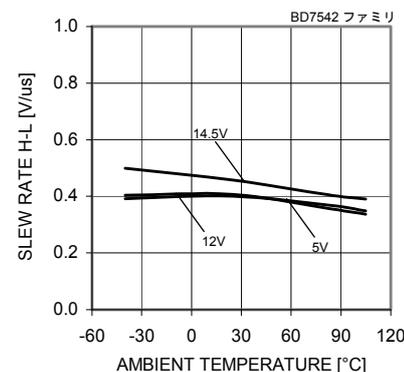


Fig. 91

スルーレート(H-L)—温度特性

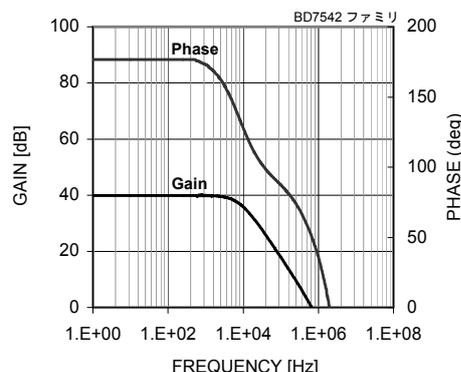


Fig. 92

電圧利得—周波数特性

(*)上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。BD7561 : -40[°C]~+85[°C] BD7561S : -40[°C]~+105[°C]

●内部等価回路図

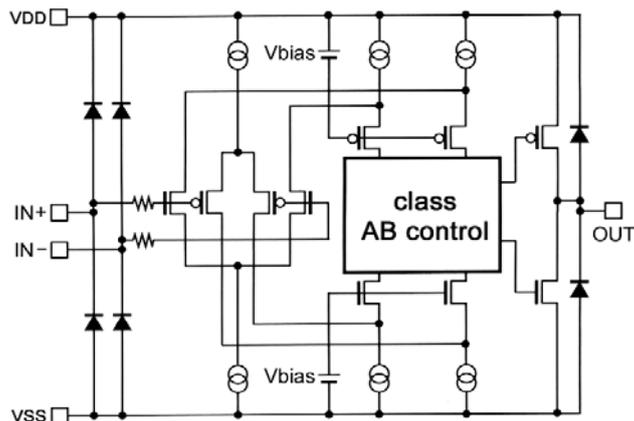


Fig. 93 内部等価回路図

●測定回路 1 NULL 法測定条件

VDD, VSS, EK, Vicm の単位:[V]

測定項目	VF	S1	S2	S3	VDD	VSS	EK	Vicm	計算式
入力オフセット電圧	VF1	ON	ON	OFF	12	0	-6	12	1
大振幅電圧利得	VF2	ON	ON	ON	12	0	-0.5	6	2
	VF3						-11.5		
同相信号除去比 (同相入力電圧範囲)	VF4	ON	ON	OFF	12	0	-6	0	3
	VF5						12		
電源電圧除去比	VF6	ON	ON	OFF	5	0	-2.5	0	4
	VF7				14.5				

—計算式—

1. 入力オフセット電圧 (Vio)
$$V_{io} = \frac{|VF1|}{1+R_f/R_s} \text{ [V]}$$

2. 大振幅電圧利得 (Av)
$$A_v = 20 \text{Log} \frac{11 \times (1+R_f/R_s)}{|VF2-VF3|} \text{ [dB]}$$

3. 同相信号除去比 (CMRR)
$$CMRR = 20 \text{Log} \frac{12 \times (1+R_f/R_s)}{|VF4-VF5|} \text{ [dB]}$$

4. 電源電圧除去比 (PSRR)
$$PSRR = 20 \text{Log} \frac{9.5 \times (1+R_f/R_s)}{|VF6-VF7|} \text{ [dB]}$$

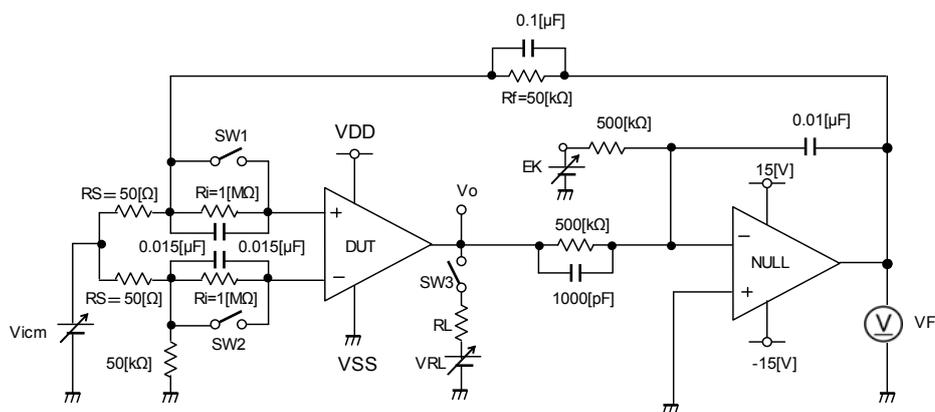


Fig. 94 測定回路 1 (1チャンネルのみ)

●測定回路 2 SW 条件

単位:[V]

SW No.	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	SW 7	SW 8	SW 9	SW 10	SW 11	SW 12
回路電流	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
最大出力電圧 RL=10 [kΩ]	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
出力電流	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
スルーレート	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
最大周波数	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON

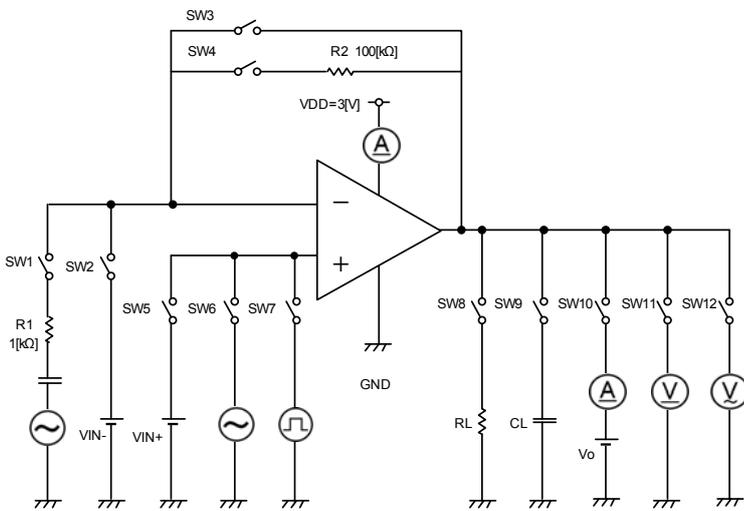


Fig. 95 測定回路 2

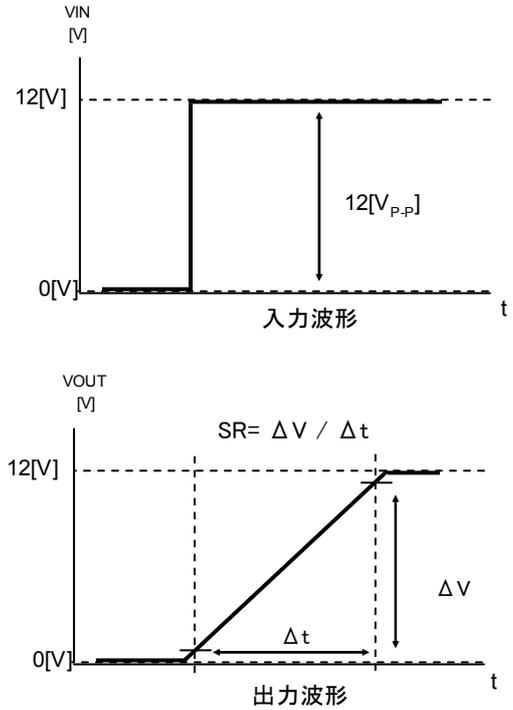


Fig. 96 スルーレート測定時 入出力波形

●測定回路 3 チャンネルセパレーション

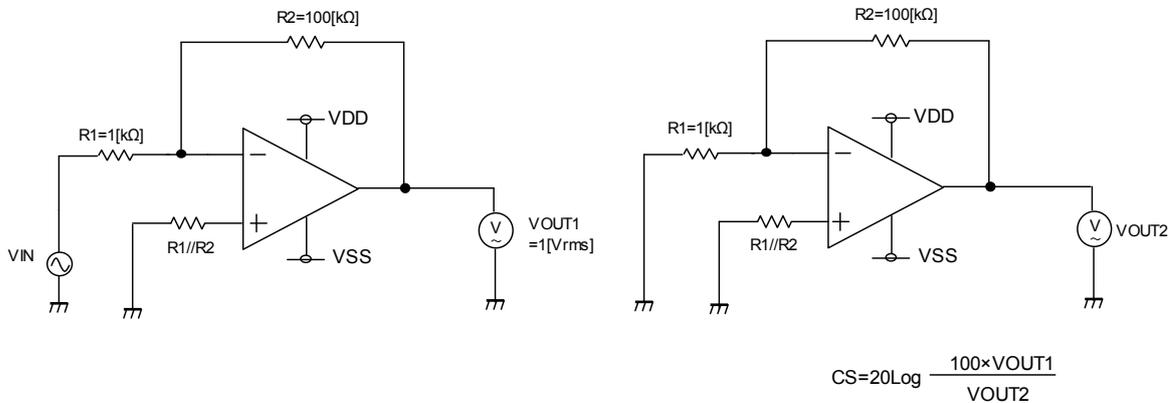


Fig. 97 測定回路 3

●電氣的特性用語説明

ここでは本 Technical Note に用いられる用語の説明を記述します。項目と一般的に使用される記号も示します。ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

1. 絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を越えた電圧の印加や絶対最大定格温度環境外での使用は、IC の特性劣化や破壊を生じる原因となります。

1.1 電源電圧 (VDD/VSS)

正側電源端子と負側電源端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.2 差動入力電圧 (Vid)

+入力端子と-入力端子の間に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.3 同相入力電圧 (Vicm)

+入力端子と-入力端子に IC の特性劣化や破壊なしに印加可能な最大電圧を示します。

最大定格の同相入力電圧範囲は IC の正常動作を保証するものではありません。IC の正常動作を期待する場合は電氣的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

1.4 許容損失 (Pd)

周囲温度 25°C(常温)および規定された実装基板で IC が消費できる電力を示しています。パッケージ製品の場合、パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合温度)とパッケージの熱抵抗によって決まります。

2. 電氣的特性項目

2.1 入力オフセット電圧 (Vio)

+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を 0[V]にする為に必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

2.2 入力オフセット電流 (Iio)

+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

2.3 入力バイアス電流 (Ib)

入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

2.4 回路電流 (IDD)

IC 個別の規定の条件および無負荷、定常状態において流れる IC 単体の電流を示します。

2.5 最大出力電圧 (VOM)

規定の負荷条件で IC が出力できる電圧範囲を示します。一般的に High レベル出力電圧と Low レベル出力電圧とに分けられます。

2.6 大振幅電圧利得 (AV)

+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。 $Av = (\text{出力電圧変動分}) / (\text{入力オフセット電圧変動分})$

2.7 同相入力電圧範囲 (Vicm)

IC が正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

2.8 同相信号除去比 (CMRR)

同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。 $CMRR = (\text{同相入力電圧変化分}) / (\text{入力オフセット変動分})$

2.9 電源電圧除去比 (PSRR)電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。

通常、直流変動分です。 $PSRR = (\text{電源電圧変化分}) / (\text{入力オフセット変動分})$

2.10 チャンネルセパレーション (CS)

駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの入力オフセット電圧の変動あるいは出力電圧の変動を示します。

2.11 スルーレート (SR)

ステップ入力信号印加時に出力される電圧の時間変化率を示します。

2.12 最大周波数 (ft)

オペアンプの利得が 1 になる周波数を示します。

2.13 全高調波歪率+雑音 (THD+N)

出力信号に対する高調波成分と雑音成分の含有率を示しています。

2.14 入力換算雑音電圧 (Vn)

オペアンプの内部で発生する雑音電圧を等価的に入力端子に直列に接続される理想電圧源で表したものです。

●ディレーティングカーブ

許容損失(全損失)は周囲温度 Ta=25°C(常温)で IC が消費できる電力を示しています。IC は電力を消費すると発熱し、IC チップの温度は周囲温度よりも高くなります。IC チップが許容できる温度は回路構成や製造プロセス等により決まり、消費できる電力は制限されます。パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大ジャンクション温度)とパッケージの熱抵抗(放熱性)によって許容損失は決まります。ジャンクション温度の最大値は通常、保存温度範囲の最大値と同じです。IC が電力を消費することで発生する熱はパッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。この放熱性(熱の逃げにくさ)を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれ、記号では θ_{j-a} [°C/W] で表されます。この熱抵抗からパッケージ内部の IC の温度を推定することができます。fig.98 (a) にパッケージの熱抵抗のモデルを示します。熱抵抗 θ_{j-a} 、周囲温度 Ta、ジャンクション温度 Tj、消費電力 P、は次式で求められます。

$$\theta_{ja} = (T_j - T_a) / P_d \quad [^{\circ}\text{C}/\text{W}] \quad \dots \dots (I)$$

Fig.98 (b) ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)は周囲温度に対して IC が消費できる電力を示しています。IC が消費できる電力はある周囲温度から減衰していきます。この傾きは熱抵抗 θ_{ja} により決定されます。熱抵抗 θ_{ja} は、同一パッケージを使用してもチップサイズ、消費電力、パッケージ周囲温度、実装条件、風速などに依存します。ディレーティングカーブは規定の条件で測定された参考値を示しています。fig.99(c)~(f)に、BD7561 ファミリ、BD7562 ファミリ、BD7541 ファミリ、BD7542 ファミリのディレーティングカーブを示します。

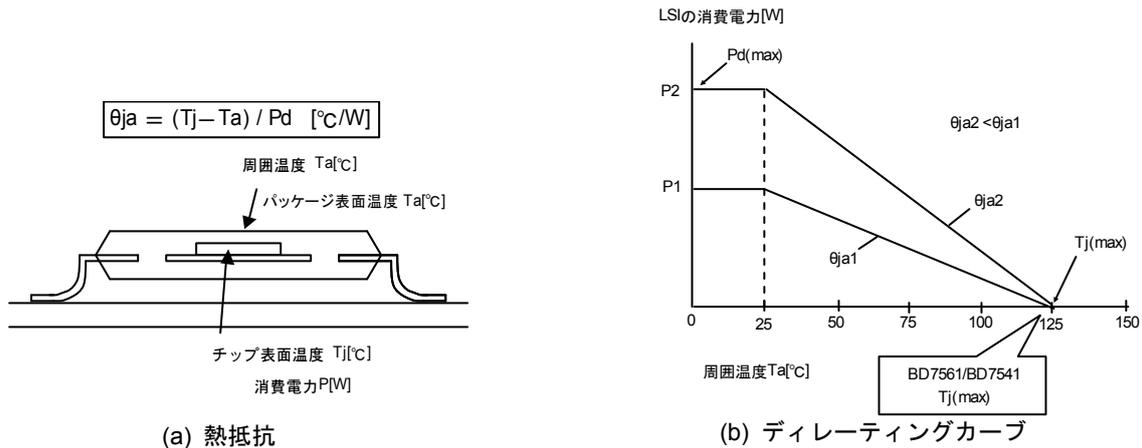
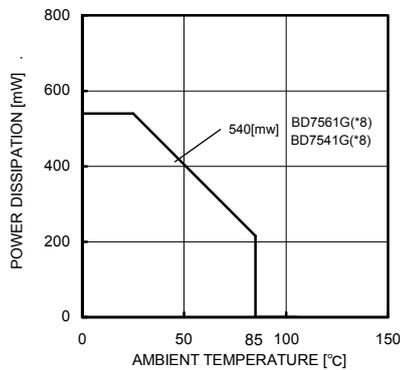
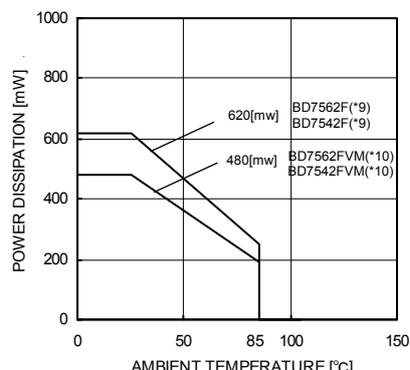


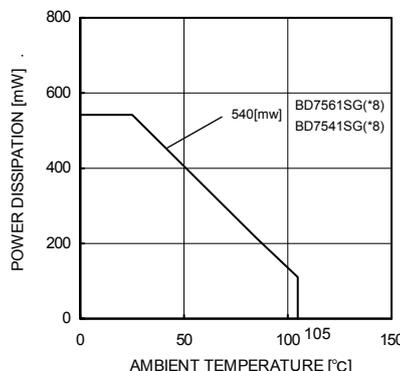
Fig. 98 熱抵抗とディレーティングカーブ



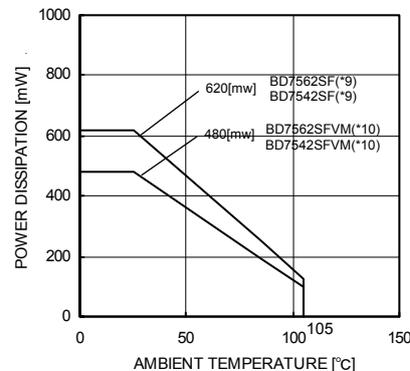
(c) BD7561G BD7541G



(d) BD7562F/FVM BD7542F/FVM



(e) BD7561SG BD7541SG



(f) BD7562S F/FVM BD7542S F/FVM

(*8)	(*9)	(*10)	単位
5.4	6.2	4.8	[mW/°C]

Ta=25°C以上で使用する場合には、1[°C]につき上記の値を減じます。
許容損失は 70[mm]×70[mm]×1.6[mm] FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3[%]以下)実装時の値です。

Fig. 99 ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)例

●使用上の注意

- 1) 絶対最大定格について
絶対最大定格とは、端子に表記範囲の電圧を印加したり、電流が流れても破壊しない限界を示す値であり、動作を保証するものではありません。
- 2) 入力端子の印加電圧について
入力端子に対しては、VSS-0.3[V]~VDD+0.3[V]の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。
ただし、これは回路動作を保証するものではありません。電気的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。
- 3) 使用電源(両電源/単電源)について
オペアンプはVDD-VSS間に所定の電圧が印加されていれば動作します。
したがって単電源オペアンプは両電源オペアンプとしても使用可能です。
- 4) 許容損失 Pd について
万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により電流能力の減少などIC本来の性質を悪化させることにつながります。実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計を行ってください。許容損失については熱軽減特性を掲載しておりますので目安としてご使用ください。
- 5) ピン間ショートと誤装着について
プリント基板に取り付ける際、ICの向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、ICが破壊する恐れがあります。また出力間や出力と電源、あるいは出力とGND間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。
- 6) 強電磁界中でのご使用について
強電磁界中でのご使用では、誤動作する可能性がありますのでご注意ください。
- 7) ICの取り扱いについて
基板のソリや曲がりなどによりICに応力が加わると、圧電(ピエゾ)効果により特性が変動する可能性があります。
基板のソリや曲がりにご注意ください。
- 8) セット基板での検査について
セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、ICにストレスがかかる恐れがあるので、1工程ごとに必ず放電を行なってください。また検査工程での治具への着脱時には、必ず電源をOFFにしてから検査を行い、電源をOFFにしてから取りはずしてください。
さらに静電気対策として、組み立て工程にアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。
- 9) 出力コンデンサについて
出力端子に接続される外付けコンデンサに電荷が蓄積された状態でVDD端子がVSS(GND)電位にショートされた場合、蓄積電荷は回路内部の寄生素子あるいは端子保護素子を通り、VDD端子に放電されるため回路内部の素子が損傷(熱破壊)する恐れがあります。
本ICを電圧比較器として使用する場合等、出力容量性負荷による発振現象が発生しないアプリケーション回路として使用する場合、上記出力端子に接続されるコンデンサの蓄積電荷によるICの損傷を防ぐため、出力端子に接続するコンデンサは0.1[μF]以下としてください。
- 10) 出力コンデンサによる発振について
本ICを使用して帰還回路を構成する応用回路をご使用の場合、容量性負荷による発振について十分確認を行ってください。
- 11) ラッチアップについて
CMOSデバイス特有のラッチアップ状態が発生する恐れがありますので入出力端子の電圧をVDD以上、VSS以下に設定しないようご注意ください。また、異常なノイズ等がICに加わらないようご注意ください。

●発注形名セレクション

B D

ローム形名

7 5 6 2

品番
7561, 7561S
7541, 7541S
7562, 7562S
7542, 7542S

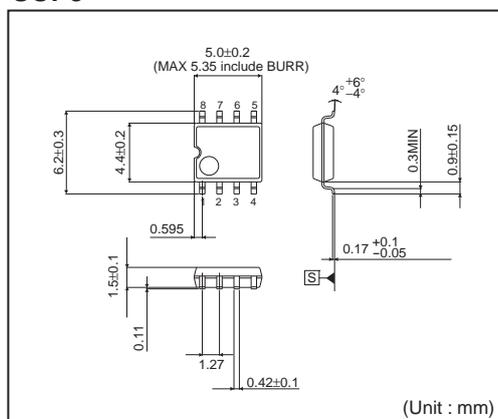
F V M

パッケージ
G: SSOP5
F: SOP8
FVM: MSOP8

T R

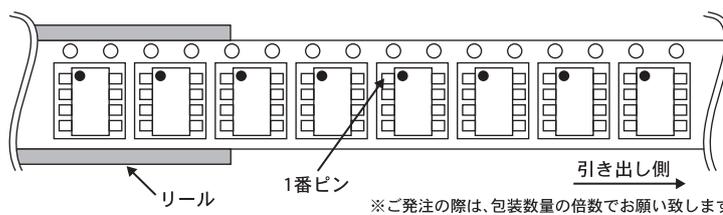
包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーピング
(SOP8)
TR: リール状エンボステーピング
(SSOP5/MSOP8)

SOP8

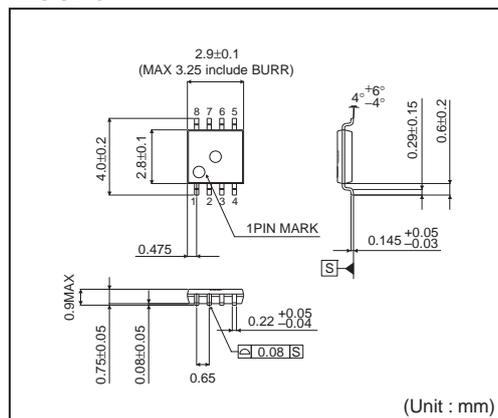


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに 製品の1番ピンが左上にくる方向)

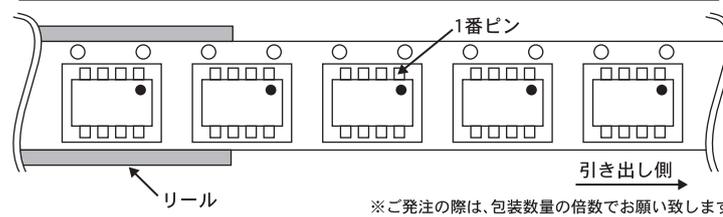


MSOP8

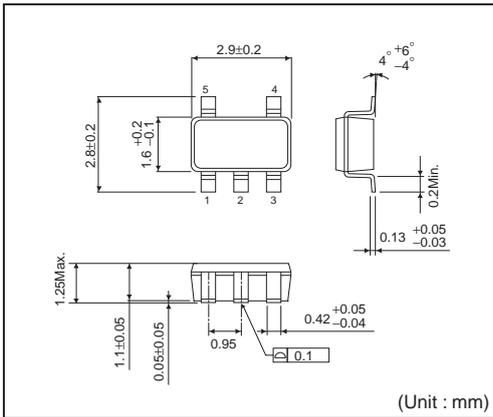


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに 製品の1番ピンが右上にくる方向)

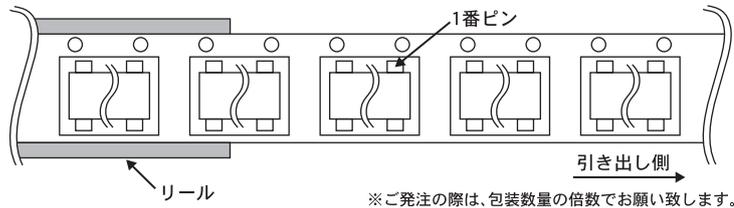


SSOP5



<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが右上にくる方向



ご 注 意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。

本知り資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされておられません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>